













| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | ZXMN10A11GTA | |
| | Hersteller-Teilenummer: | ZXMN10A11GTA |
|  | Hersteller / Marke: | Diodes Incorporated |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223 |
|  | Datenblätter: |  ZXMN10A11GTA.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Lagerzustand: | New original, 65646 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | ZXMN10A11GTA |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 65646 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-261-4, TO-261AA |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-223 |
| Verlustleistung (max) | 2W (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 1.7A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 350 mOhm @ 2.6A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 5.4nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 274pF @ 50V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

ZXMN10A11GTA ist neu im Original, Suche ZXMN10A11GTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN10A11GTA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN10A11GTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  ZXMN10A09L Diodes Diodes TO-252 |  ZXMN10A11G DIODES ZXMN10A11G DIODES |  ZXMN10A09 ZTX ZXMN10A09 ZTX |  ZXMN10A11GTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT223 |
|  ZXMN10A09K ZXTN ZXMN10A09K ZXTN |  ZXMN10A09KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 5A DPAK |  ZXMN10A25G DIODES ZXMN10A25G DIODES |  ZXMN10A11KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.4A DPAK |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  ZXMD65P02N8TC |  ZXMD65P03N8TC |  ZXMHC10A07N8TC |  ZXMHC10A07T8TA |  ZXMHC3A01N8TC |
|  ZXMHC3A01T8TA |  ZXMHC6A07N8TC |  ZXMHC6A07T8TA |  ZXMHN6A07T8TA |  ZXMN0545G |
|  ZXMN10A07FTA |  ZXMN10A07ZTA |  ZXMN10A08 |  ZXMN10A08DN8 |  ZXMN10A08DN8TA |
|  ZXMN10A08DN8TC |  ZXMN10A08E6 |  ZXMN10A08E6T |  ZXMN10A08E6TA |  ZXMN10A08E6TC |
|  ZXMN10A08G |  ZXMN10A08GTA |  ZXMN10A09K |  ZXMN10A09KTC |  ZXMN10A11G |
|  ZXMN10A11GTC |  ZXMN10A11K |  ZXMN10A11KTC |  ZXMN10A11KTC |  ZXMN10A25G |
|  ZXMN10A25GTA |  ZXMN10A25GTC |  ZXMN10A25K |  ZXMN10A25KTC |  ZXMN10B08E6 |
|  ZXMN10B08E6TA |  ZXMN15A27KTC |  ZXMN2088DE6TA |  ZXMN20B28KTC |  ZXMN2A01E6TA |
|  ZXMN2A01FTA |  ZXMN2A01FTC |  ZXMN2A02N8 |  ZXMN2A02N8TA |  ZXMN2A02N8TC |
|  ZXMN2A02X8TA |  ZXMN2A02X8TC |  ZXMN2A03E6 |  ZXMN2A03E6TA |  ZXMN2A04DN8 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited